

NORME  
INTERNATIONALE  
INTERNATIONAL  
STANDARD

CEI  
IEC  
747-3

1985

AMENDEMENT 1  
AMENDMENT 1

1991-10

---

---

Amendement 1

**Dispositifs à semiconducteurs**  
Dispositifs discrets

**Troisième partie:**  
Diodes de signal (y compris les diodes  
de commutation) et diodes régulatrices

Amendment 1

**Semiconductor devices**  
Discrete devices

**Part 3:**  
Signal (including switching) and regulator diodes

© CEI 1991 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève Suisse



Commission Electrotechnique Internationale  
International Electrotechnical Commission  
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX  
PRICE CODE

F

● Pour prix, voir catalogue en vigueur  
For price, see current catalogue

## AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le Comité d'Etudes n° 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapports de vote
47(BC)950	47(BC)990
47(BC)1074	47(BC)1172
47(BC)1076	47(BC)1173A
47(BC)1120	47(BC)1275

Les rapports de vote indiqués dans le tableau ci-dessus donnent toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 12

## CHAPITRE II – TERMINOLOGIE ET SYMBOLES LITTÉRAUX

SECTION UN – DIODES DE SIGNAL (Y COMPRIS  
LES DIODES DE COMMUTATION)

*Remplacer, à la page 16, le paragraphe 2.4.3 existant par le nouveau paragraphe suivant:*

**2.4.3 Temps de recouvrement direct  $t_{fr}$  (d'une diode de redressement ou d'une diode de signal)**

Intervalle de temps entre l'instant où la tension directe croît en passant par une première valeur spécifiée et celui où elle décroît de sa valeur de pointe  $V_{FRM}$  à une seconde valeur spécifiée proche de la valeur stable finale de la tension directe (méthode A comme il est indiqué sur la figure 29), ou celui où elle atteint par extrapolation la valeur zéro (méthode B comme il est indiqué sur la figure 30), après application d'un échelon spécifié de courant, à partir d'une tension nulle ou d'une autre tension inverse spécifiée.

## NOTES

- 1 Les première et seconde valeurs spécifiées indiquées dans la définition sont fixées généralement à 10 % et 110 %, respectivement, de la valeur stable finale de la tension directe ( $V_F$  sur les figures 29 et 30).
- 2 L'extrapolation est effectuée en traçant une droite passant par deux points A et B spécifiés, comme il est indiqué sur la figure 30.

## PREFACE

This amendment has been prepared by IEC Technical Committee No. 47: Semiconductor devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

Six Months' Rule	Reports on Voting
47(CO)950	47(CO)990
47(CO)1074	47(CO)1172
47(CO)1076	47(CO)1173A
47(CO)1120	47(CO)1275

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the Voting Reports indicated in the above table.

Page 13

## CHAPTER II – TERMINOLOGY AND LETTER SYMBOLS

SECTION ONE – SIGNAL DIODES  
(INCLUDING SWITCHING DIODES)

*Replace, on page 17, the existing subclause 2.4.3 by the following new subclause:*

**2.4.3 Forward recovery time  $t_{fr}$  (of a rectifier diode or signal diode)**

The time interval between the instant when the forward voltage rises through a specified first value and the instant when it falls from its peak value  $V_{FRM}$  to a specified second value close to the final stable value of forward voltage (specification method A as shown in figure 29), or when the extrapolated forward voltage reaches zero (specification method B as shown in figure 30), upon the application of a specified step of forward current following a zero-voltage or other specified reverse-voltage condition.

## NOTES

- 1 The specified first and second values referred to in the definition are usually 10 % and 110 %, respectively, of the final stable value ( $V_F$  in figures 29 and 30).
- 2 The extrapolation is carried out with respect to specified points A and B as shown in generalized form in figure 30.